

特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

代理人 木村満 あて名 〒101-0054 日本国東京都千代田区神田錦町一丁目 ビル2階	RECEIVED MAY 25 2005 ASHIDA & KIMURA	様
---	--	---

PCT
 国際調査機関の見解書
 (法施行規則第40条の2)
 [PCT規則43の2.1]

発送日
 (日.月.年)

24. 5. 2005

出願人又は代理人
 の書類記号 04F067-PCT

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号
 PCT/J P 2005/003161

国際出願日
 (日.月.年) 25. 02. 2005

優先日
 (日.月.年) 26. 03. 2004

国際特許分類 (IPC) IntCl.⁷ H01L29/78, 21/822, 27/04, 27/06, 21/336

出願人 (氏名又は名称)
 サンケン電気株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☒ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

06. 05. 2005

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

松嶋 秀忠

4M

9836

電話番号 03-3581-1101 内線 3462

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

第I欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

☐ この見解書は、_____語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 書面

☐ コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる

☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-18	有 無
	請求の範囲		
進歩性 (I S)	請求の範囲	13-17	有 無
	請求の範囲	1-12, 18	
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲	1-18	有 無
	請求の範囲		

2. 文献及び説明

文献 1: JP 7-50413 A(シリコニックス・インコーポレイテッド) 1995. 02. 21

文献 2: JP 10-506503 A(フィリップス エレクトロニクス ネムローゼ フェンノートシャップ)
1998. 06. 23

文献 3: JP 10-501103 A(フィリップス エレクトロニクス ネムローゼ フェンノートシャップ)
1998. 01. 27

文献 4: JP 4-154173 A(株式会社東芝) 1992. 05. 27

請求の範囲 1-7

請求の範囲 1-6 に記載された発明は、文献 1 乃至 3 から進歩性を有さない。

請求の範囲 7 に記載された発明は、文献 1 乃至 3 と文献 4 から進歩性を有さない。

文献 1 乃至 3 に記載された半導体装置を、本願出願時周知技術であるリング状のゲート構造を有する半導体装置とすることは、当業者にとって容易である。

また、文献 4 には、バックゲート領域電極取り出し用のコンタクト拡散層（「第 8 半導体領域 (12)」に相当）を形成することが開示されている。

請求の範囲 8-12

請求の範囲 8-11 に記載された発明は、文献 3 から進歩性を有さない。

請求の範囲 12 に記載された発明は、文献 3 と文献 4 から進歩性を有さない。

文献 3 に記載された半導体装置を、本願出願時周知技術であるリング状のゲート構造を有する半導体装置とすることは、当業者にとって容易である。

また、文献 4 には、バックゲート領域電極取り出し用のコンタクト拡散層（「第 8 半導体領域 (12)」に相当）を形成することが開示されている。

なお、文献 3 に記載された「p 形の埋め込み領域 18」（「第 4 半導体領域 (14)」に相当）は、「サブ区域 6b」（「第 3 半導体領域 (13)」に相当）よりもドレインコンタクト側に延伸するように形成されている突片部（図 2 参照）と、前記突片部よりもドレインコンタクト側に延伸しないように形成されている部分（図 3 参照）とを有していることが記載されている（文献 3 は、「サブ区域 6b」の長さを変化させている点で、本願発明の実施例とは異なるが、本願の請求の範囲に記載された文言では、文献 3 に記載された発明も含まれるものと判断せざるを得ない）。

第Ⅳ欄 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

- ・請求の範囲 18 に記載された「高圧抵抗素子(121)」とは、どのような抵抗素子を示すのか技術的に不明瞭な記載である。

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V2. 欄の続き

請求の範囲 13-17

請求の範囲 13-17 に記載された発明は、文献 1 乃至 4 のいずれの文献にも開示されておらず、また、当業者にとって自明なものとも認められない。

請求の範囲 18

請求の範囲 18 に記載された発明は、文献 3 から進歩性を有さない。

文献 3 に記載されたトランジスタに抵抗素子を組み合わせることは、当業者にとって格別の困難性は認められない。